Реєстраційна картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0109U000943

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 27-03-2009

II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК):

У тому числі по роках:
Загальний обсяг фінансування: 248.533 тис. грн.

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги, 10, м. Київ, Київ, 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442878922, 0442878922

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Код за ЄДРПОУ: 02071091

Місцезнаходження: вул. Дворянська 2, м. Одеса, Одеська обл., 65058, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0487235254

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Дослідження радіаційних ефектів в напівпровідникових інжекційних структурах з p-n-, p-i-n- і гетеропереходами

Назва роботи англійською:

The investigations of the radiation effects into the semiconductors injection structures with p-n-, p-i-n- and heterojunctions

Мета роботи українською:

Створення удосконаленої концепції фізичних механізмів впливу радіаційного опромінення на електрофізичні процеси в напівпровідникових інжекційних структурах з p-n-, p-i-n- і гетеропереходами, а також в структурах з квантовими ямами (структури метал-діелектрик-напівпровідник).

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Удосконалена концепція фізичних механізмів впливу радіаційного опремінення на електрофізичні процеси в напівпровідникових інжекційних структурах з p-n-, p-i-n- і гетеропереходами, а також в структурах з квантовими ямами. Механізми впливу радіаційного опромінювання на характеристики областей об'ємного заряду, відповідних за формування фізичних та функціональних параметрів фото- та магніточутливих приладів мікро- та наноелектроніки з інжекцією нерівноважних носіїв заряду в об'єм напівпровідника.

Галузь застосування:

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Курмашев Шаміль Джамашевич

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Дослідження радіаційних ефектів в напівпровідникових інжекційних структурах з p-n-, p-i-n- і гетеропереходами

Початок етапу: 01.2009

Закінчення етапу: 12.2011

Вид звітного документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 621.38.01, 621.382.2/3;62.192

Коди тематичних рубрик: 47.03

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Сминтина Валентин Андрійович
д. ф.-м. н., 01.04.10

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.